

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ
ФИЗИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
им. В.Е. ЛАШКАРЕВА

О ПТОЭЛЕКТРОНИКА
и
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
ТЕХНИКА

OPTOELECTRONICS
and
SEMICONDUCTOR
TECHNICS

КІЕВ
НАУКОВА ДУМКА
2010

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
ОСНОВАН В 1982 г.

ВЫПУСК 45

СОДЕРЖАНИЕ

Мачулін В.Ф. Інституту фізики напівпровідників ім. В.С. Лашкарьова НАН України — 50 років	5
Свечников Г.С., Морозовская А.Н. Наноинтеграция и самосборка в наноэлектронике (обзор)	11
Толмачев И.Д., Сtronский А.В. Оптические нелинейности в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (обзор)	27
Хміль Д.Н., Камуз А.М., Олексенко П.Ф., Алексенко Н.Г., Камуз В.Г. Экспресс-метод определения наименьшей разницы цветов испытуемого люминофора и белого света	49
Литовченко Н.М., Насека Ю.Н., Прохорович А.В., Ращковецкий Л.В., Стрильчук О.Н., Сизов Ф.Ф., Войцеховская О.О., Данильченко Б.А. Анализ фотолюминесценции кристаллов $p\text{-Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$, облученных γ -квантами	54
Венгер Е.Ф., Євтушенко А.І., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Поверхневі поляритони в монокристалах 6H-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі	61
Баранський П.І., Гайдар Г.П. Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем іnanoструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникової сполук	69

<i>Власенко Н.А., Сопинский Н.В., Гуле Е.Г., Велигуря Л.И., Братусь В.Я., Мельник Р.С., Денисова З.Л., Мухльо М.А.</i> Влияние пленки SiO _x , нанесенной термическим испарением, на краевую люминесценцию монокристаллического кремния	76
<i>Данько В.А., Індутний І.З., Михайлівська К.В., Шепелявий П.Є.</i> Фотолюмінесценція поруватих nc-Si—SiO _x nanoструктур, оброблених парами HF	83
<i>Павлюченко А.С., Кукла А.Л., Голтвянський Ю.В., Архипова В.М., Дзядевич С.В., Солдаткин А.П.</i> Исследование стабильности характеристик рН-чувствительных полевых транзисторов	90
<i>Венгер Е.Ф., Готовы И., Шеховцов Л.В.</i> Латеральная фотоЭДС в контакте Шоттки	100
<i>Сукач А.В., Тетъоркін В.В., Мазарчук І.О., Кролевець М.М., Лук'яненко В.І., Луцишин І.Г.</i> Вплив поверхневої провідності на електричні властивості мезаструктурних InAs p—n-переходів	109
<i>Павлович І.І., Копил О.І., Томашик В.М.</i> Легування термоелектричного матеріалу електроактивними домішками	117
<i>Вахула О.А., Хоруженка В.Ю., Кукла О.Л., Самойлова І.О., Шульженко О.В., Манорик П.А.</i> Оптоелектронний колориметричний сенсор аміаку	122
<i>Костюкевич Е.В., Костюкевич С.А.</i> Сенсор поверхностного плазмонного резонанса для определения уровня барбитуратов в жидкой пробе	130
<i>Христосенко Р.В., Костюкевич Е.В., Зыньо С.А., Павлюченко А.С., Самойлов А.В., Ушенин Ю.В., Костюкевич С.А., Кальченко В.И.</i> Газовый сенсор на поверхностных плазонах для распознавания спиртов с использованием чувствительных пленок каликсаренов	137

CONTENTS

<i>Machulin V.F.</i> , V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS Ukraine — 50 years old	5
<i>Svechnikov G.S.</i> , <i>Morozovska A.N.</i> Nanointegration and self-assembling in nanoelectronics (review)	11
<i>Tolmachov I.D.</i> , <i>Stronski A.V.</i> Optical nonlinearities in chalcogenide vitreous semiconductors (review)	27
<i>Khmil D.N.</i> , <i>Kamuz A.M.</i> , <i>Oleksenko P.Ph.</i> , <i>Aleksenko N.G.</i> , <i>Kamuz V.G.</i> Quick test to define the least color difference of experimental luminescent solid and white light	49
<i>Litovchenko N.M.</i> , <i>Naseka Yu.M.</i> , <i>Prohorovich A.V.</i> , <i>Rashkovetskyi L.V.</i> , <i>Strilchuk O.M.</i> , <i>Sizov F.F.</i> , <i>Voitsihovska O.O.</i> , <i>Danilchenko B.O.</i> Analysis of photoluminescence of $p\text{-Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ crystals irradiated by γ -quanta	54
<i>Venger E.F.</i> , <i>Yevtushenko A.I.</i> , <i>Melnichuk L.Yu.</i> , <i>Melnichuk O.V.</i> Surface polaritons in 6H-SiC single crystals placed in a strong uniform magnetic field	61
<i>Baranski P.I.</i> , <i>Gaidar G.P.</i> Radiation and thermal stability of thin layers, heterosystems and nanostructures, created on the basis of elementary semiconductors and semiconductor compounds	69
<i>Vlasenko N.A.</i> , <i>Sopinsky M.V.</i> , <i>Gule E.G.</i> , <i>Veligura L.I.</i> , <i>Bratus V.Ya.</i> , <i>Melnik R.S.</i> , <i>Denisova Z.L.</i> , <i>Mukhlyo M.A.</i> Influence of SiO_x -film deposited by thermal evaporation on the near-bandedge luminescence of mono-crystalline silicon	76
<i>Dan'ko V.A.</i> , <i>Indutnyi I.Z.</i> , <i>Michailovska K.V.</i> , <i>Shepeliavyi P.E.</i> Photoluminescence of porous nc-Si— SiO_x nanostructures treated by HF vapors	83
<i>Pavluchenko A.S.</i> , <i>Kukla A.L.</i> , <i>Goltvianskyi Yu.V.</i> , <i>Arkhypova V.M.</i> , <i>Dzyadevych S.V.</i> , <i>Soldatkin A.P.</i> Investigation of stability of the pH-sensitive field effect transistors	90
<i>Venger E.F.</i> , <i>Hotovy I.</i> , <i>Shekhovtsov L.V.</i> Lateral photo-emf in Schottky contact	100
<i>Sukach A.V.</i> , <i>Tetyorkin V.V.</i> , <i>Mazarchuk I.O.</i> , <i>Krolevets M.M.</i> , <i>Lukyanenko V.I.</i> , <i>Lutsishyn I.G.</i> Effect of surface conductivity on electrical properties of mesa-structure InAs $p\text{-}n$ -junctions	109
<i>Pavlovych I.I.</i> , <i>Kopyl O.I.</i> , <i>Tomashyk V.M.</i> Doping of a thermoelectric material by electroactive impurities	117
<i>Vakhula A.A.</i> , <i>Khoryzhenko V.Yu.</i> , <i>Kukla A.L.</i> , <i>Samoylova I.A.</i> , <i>Shylzhenko O.V.</i> , <i>Manorik P.A.</i> Optoelectronic colorimetric ammonia sensor	122
<i>Kostyukevych E.V.</i> , <i>Kostyukevych S.A.</i> Surface plasmon resonance sensor for determination of the barbiturate level in a liquid sample	130
<i>Khristosenko R.V.</i> , <i>Kostyukevych E.V.</i> , <i>Zynio S.A.</i> , <i>Pavlyuchenko A.S.</i> , <i>Samoylov A.V.</i> , <i>Ushenin Yu.V.</i> , <i>Kostyukevych S.A.</i> , <i>Kalchenko V.I.</i> Surface plasmon based gas sensor for alcohols discrimination utilizing sensitive calixarene films	137